科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 28 年 4 月 26 日現在

機関番号: 12601 研究種目: 若手研究(B) 研究期間: 2014~2015

課題番号: 26800210

研究課題名(和文)マクロ振動子のエンタングルメント生成

研究課題名(英文)Entanglement generation of macro oscillator

研究代表者

山崎 歴舟 (Yamazaki, Rekishu)

東京大学・先端科学技術研究センター・助教

研究者番号:00551409

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,000,000円

研究成果の概要(和文):オプトメカニクスおよびエレクトロメカニクスを用いてマクロ振動子のエンタングルメント状態生成に向けて実験を行った。1,000,000という高い位を持つSi3N4薄膜振動子を光およびマイクロ波共振器と結合する実験系を構築し振動子の電磁波による操作を行った。光のレーザー冷却では室温の300Kから50mKまで振動モードの冷却が確認された。またマイクロ波では希釈冷凍機温度(10mK)から振動基底状態までの冷却が達成された。マイクロ波の実験ではマイクロ波共振器と薄膜振動子の量子強結合が確認されたほか、異なる振動モード間を共振器を媒介としたパラメトリック結合させることで振動子モード間の強結合も確認された。

研究成果の概要(英文): We performed the experimental investigation towards the entanglement generation of macro oscillator. Using a stoichiometric silicon nitride membrane (Si3N4), with high quality factor of 1,000,000, as a mechanical oscillator, combining with electromagnetic resonators, we constructed optomechanical and electromechanical system. We performed series of experiments to control the state of membrane oscillator via electromagnetic wave. Laser cooling of the membrane, starting from 300K, to 50mK was observed with the optomechanical system. For the electromehcanical system, we cooled the oscillator down to the quantum ground state from the dilution temperature of 10mK. In the electromechanical system, we observed quantum strong coupling between the microwave resonator and the mechanical oscillator. We also observed the strong coupling between two mechanical modes through a parametric coupling via a common microwave resonator mode.

研究分野: 量子ハイブリッド系

キーワード: オプトメカニクス エレクトロメカニクス 強結合 ハイブリッド量子系

1.研究開始当初の背景

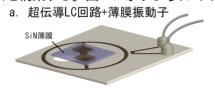
- (1) 2011 年にマクロ振動子の基底状態までの冷却が光およびマイクロ波領域におけるオプトメカニクス・エレクトロメカニクスと呼ばれる実験系を用いて達成された。これによりマクロ振動子の量子操作、いわゆる量子メカニクスが現実のものとなり量子情報処理や量子センサーへの応用、またマクロな物体の量子制御が新たな基礎物理への探求を可能とすることが示唆された。
- (2) 日本においては量子メカニクスの研究はまだされておらず、重力波検出のチームがオプトメカニクスの古典領域での研究を進めていた状況である。本研究において日本でさきがけて量子メカニクスの研究を進めていく。

2. 研究の目的

本研究ではマクロ振動子の振動状態を量 子操作により初期化・操作することにある。 量子情報処理においては計算資源とされる エンタングルメント状態の生成は応用への 興味だけではなくマクロ振動子の量子状態 という基礎物理にも影響を与えうる新奇な 状態である。近年注目されているオプトメカ ニクスという実験系を光・マイクロ波の両領 域で構築し、電磁波による振動子の操作を行 うことでエンタングルメント状態の生成を 目指す。オプトメカニクス系では電磁波によ る振動子(もしくは振動子による電磁波)の 操作・制御を行うが、単一量子レベルでの振 動子中のフォノンや光子にはレーザー冷却 技術による振動子の基底状態までの冷却、電 磁波と振動子の強結合などの基礎技術を確 立する必要がある。本研究ではこれら基礎技 術を通してエンタングルメント状態生成を 行い、また同時に量子ナノメカニクスの研究 につながる礎の構築に挑む。

3.研究の方法

(1) オプトメカニクス・エレクトロメカニクス系の構築 : 約 1mm の大きさの Si₃N₄ 薄膜を振動子として用いたオプトメカニクスの系を構築する。図 1a 示すようにマイク



b. 光共振器+薄膜振動子

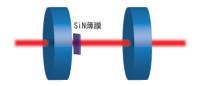


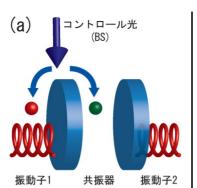
図 1 オプトメカニクス・エレクトロメ カニクス系の機築

口波共振器(LC 共振器)の一部である平板コ ンデンサを薄膜振動子を用いて構成するこ とにより、マイクロ波共振器と振動子が結合 したエレクトロメカニクス系を構築する。 SiN 薄膜上の電極やチップ上の回路をアルミ 電極でパターニングすることにより 1K 以下 の低温で非常に損失の少ない超伝導回路が 構成される。また光領域のオプトメカニクス 系では同薄膜を図 1b のように光共振器内に 挿入することにより薄膜の変位が光共振器 の共振器長を実効的に変えるようなオプト メカニクス系が構築される。次のステップで 行うレーザー冷却では高いフィネスの光共 振器が求められるが、低温環境でもひずみが 小さい共振器母体の素材や接着剤などの選 定を考慮して系の構築を行わなくてはなら ない。

- (2) レーザー冷却 : 各々の系においてレ ーザー冷却手法の一つであるサイドバンド 冷却法を用いて振動子の冷却を行う。オプト メカニクス系では室温からの冷却では振動 子の基底状態までの冷却は困難と思われる ため、クライオスタットを用いて 4K まで予 備冷却の上で実験を行う。この時クライオス タットによる振動や光共振器の低温環境へ の導入など、テクニカルな問題が伴うことが 容易に予想される。エレクトロメカニクスで は希釈冷凍機内の 10mK の環境から同様にマ イクロ波でのサイドバンド冷却を行う。どち らの実験系においても冷却光もしくはプロ -ブ光が振動子によって変調されたサイド バンドの分光を行うことで、冷却による振動 子モードの温度を測定することが可能であ る。振動子の温度が低下するに伴い信号自体 も小さくなるので SN 比の非常に高い測定系 を用いて振動子によるサイドバンドを測定 する必要がある。
- (3) 電磁波を用いた振動子のコヒーレント操作とエンタングルメント状態生成 : 上記の振動基底までの冷却は振動子の量子状態の初期化にあたる。振動子のエンタングルメント状態生成には、初期化の後にコヒーレントな量子操作が必要となる。まずは電磁波共振器と振動子間でのコヒーレント操作を試みる。基底状態までの冷却を行わないでも、コヒーレント操作の確認が可能なのptomechanically induced transparency (OMIT)と呼ばれる現象があるが、これらの測定を行いコヒーレント操作を評価する。

エンタングルメント生成に用いる振動子と共振器内の電磁波の結合はコントロール光の周波数によって可変である。Blue-sideband (BS)と Red-sideband (RS)と呼ばれるコントロール光は、各々振動子と電磁波の対生成と交換の操作に対応している。エンタングルメント生成の原理を図2に示す。基底状態まで冷却された振動子1と共振器にBS操作をすると、振動子のフォノンが生成さ

れ共振器内に も光子が生成 される。共振 器内の光子を 次はRSを使っ て振動子 2 と 交換すると振 動子 1,2 の間 にそれぞれ 1 フォノンが存 在することに なる。詳細は 省くが上記の 工程をBSだけ 半分の強さで 照射すると振 動子 1.2 に 各々0 か 1 個 のフォノンが いるエンタン グルメント状 態が生成でき る。この手法 は振動子が基 底状態まで冷 却できている という条件で 成り立つが世



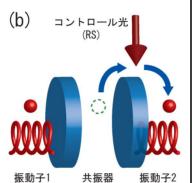


図 2 エンタングルメント 生成に用いられる操作の概 念図

界でもまだ3つの報告しかない基底状態までの冷却は容易とは言えない。レーザー冷却の手法を用いて冷却を試みる準備はしており、現在構築中の系において基底状態まで冷却が可能なことを数値シミュレーションで確認している。

イオントラップを用いた量子情報操作も同様の困難があったが、幾何学的位相を用い動程によって振動子が励起状態にあって振動子がは大きされる。オプトメカニクスでも同様に幾何でもの暗状態を用いるものと量子でものが提案でしている。3 準位系を用いるこれらの起までいる。3 準位系を用いるこれらの起までいる。4 本のよりできない。200 と見積もない場合がは振動子のと見積もない場合がは大りできない場合ができるこの特徴を生かしたこの手法を特に進めていく。

4. 研究成果

(1) オプトメカニクス・エレクトロメカニクス系の構築: 構築された代表的なオプトメカニクス・エレクトロメカニクス実験系を図3に示す。研究開始当初は図3aのような2次元回路基板を用いた超伝導回路の構築を想定していたが図3bのような3D共振器を用いた構成では定常的に10⁵という高い共振器Q値に加え内部損失が著しく低い高性能な共振器の作製が行えた。また3D共振器の中心

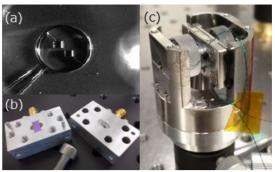


図 3 構築されたオプトメカニクス・エレク トロメカニクス実験系

部分にあるように振動子部分をチップ化することでチップ部分だけを交換できるルできるとでチップ部分だけを交換できるルである。平板コンデンサを構成するチップ電極 薄膜電極間のギャップは 300nmと非常に小さいため作製に困難が伴いサンという電磁波と振動子の高い結合オプインである。共振器の中心である。共振器環境でもりがチカーを用い、Stycast という低温環境でもりしてある、光共振器の中心部分にはSiN薄膜が接着加いて共振器の中心部別にはSiN薄によるのフィネスは約 30,000 程度である。

(2) レーザー冷却 : 各々の実験系でレーザ 冷却を行った。オプトメカニクス系では 4K のクライオスタットの振動ノイズの問題が 最後にやっと解決したので室温からの冷却しか行えなかった。レーザー冷却時における 振動子のサイドバンド分光をレーザー冷却光の強度を変えて行った。冷却光の強度を上げていくにつれて(スペクトラの下の方がレーザー強度が強い)振動子の分光スペクトラの線幅が広がリピーク強度が下がっているのがわかる。線幅の増加は導入された電磁波

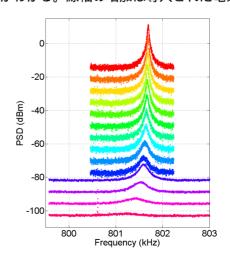


図 4 レーザー冷却における振動 子のノイズ分光スペクトラ

により振動子フォノンの散逸が増えていることを表し、ピーク強度の低下は振動子の振幅の減少、つまり振動子の冷却を表している。振動子の線幅の変化から冷却後の振動子の温度を見積もることができ、300Kから50mKまでの冷却が確認された。クライオスタットで初期温度が4Kにできることでさらなる冷却が可能となるはずで振動基底までの冷却を令後目指したい。エレクトロメカニクスでは高い結合強度と希釈冷凍機内の予備冷却により振動基底までの冷却を確認した。世界で4番目の報告となり論文化を進めている。

(3) 電磁波を用いた振動子のコヒーレント 操作とエンタングルメント状態生成 : 磁波を用いた振動子のコヒーレント操作に は電磁波と振動子間の結合強度が電磁波と 振動子の散逸レートよりも高い「強結合」と 呼ばれる領域にある必要がある。エレクトロ メカニクス系では量子操作に必要な結合強 度の 2,000 倍の結合強度を確認している。ま た図 5a に示すように薄膜振動子には異なる 振動モードが存在しこれらは共通の電磁波 の共振器モードと結合できる。異なる二つの 振動子モードを共通の電磁波モードを介し てパラメトリックに結合できること、またこ の結合強度が強結合の領域にあることを示 した。図 5c は二つの振動モードのエネルギ ースペクトラが反交差する様子である。反交 差の間隔は結合強度を白いスペクトラの幅 は散逸レートを表すが、反交差のギャップの 方が線幅よりも広く強結合の領域にあるこ とがわかる。この実験で異なる二つの振動モ ードの強結合は確認されたが、まだ量子操作 には結合強度が足りないことが解析から判 明した。しかし、異なる二つの振動モードで ここまでの強結合が出来ている報告はなく、 振動子のエンタングルメント状態生成に非 常に近いレベルでの操作が可能となってい る。

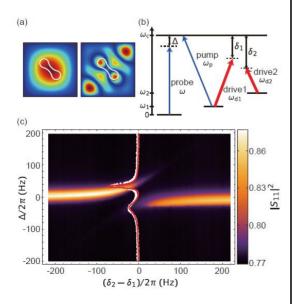


図 5 異なる二つの振動モードの強結合

(4) フォノニック結晶および表面弾性波デ バイスの開発 : 上記の主要実験のほか、 フォノニック結晶や表面弾性波デバイス (SAW デバイス)の構築も試みた。フォノニッ ク結晶は共振器ではなく振動子自体の散逸 をさらに抑えこむ事が可能となり振動子を 用いた量子メモリーなどへの応用が期待さ れる。本研究では SiN 薄膜振動子が張ってい る Si 基板自体にフォノニック結晶構造を彫 り込むことで薄膜へのフォノンの流入を防 ぐ加工でこれらの作製とシミュレーション との合致も確認している。今後さらなる振動 子の高性能化へ応用が期待される。また表面 弾性波を用いたデバイスではSiN薄膜振動子 の約100倍とフォノンの振動周波数を上げる ことが可能である。振動子の高周波数化は冷 却に有利なほか、マイクロ波との結合強度の 増加や量子操作の高速化にもつながる。水晶 を用いた SAW デバイスでは希釈冷凍機温度で 100のQ値を観測している。また定量的な観測 はまだ行っていないが光弾性の結合強度も 比較的強いようで SAW を励起したサンプルの 光の透過測定を行うことでサンプル表面に おける SAW パターンの可視化も実験的に確認 できている。また SAW を一点に集中させ光学 弾性結合定数を飛躍的に上げる SAW Focusing の技術も確立しつつある。これらの技術革新 は本研究の提案当初には予定されていなか ったが今後大きく期待される技術と考えて いる。

(5)まとめ

本研究では当初の目的であった振動子のエンタングルメント生成にはおよばなかったものの、振動子と電磁波結合では世界でもトップレベルの結合強度を観測している。また二つの異なるモード間の結合強度では更要ないできた。今後の展望としては上記のSAWデイスを取り入れたさらなる進展や光・マしたバイスを取り入れたさらなる進展や光・マしたイブリッド量子系の開発や広いエネの地理の進展が望める。

5.主な発表論文等 〔雑誌論文〕(計 0件)

[学会発表](計 8件)

野口 篤史 他、マイクロ波光子と薄膜 振動子の強結合の実現、日本物理学会第 71 回年次大会、2016 年 3 月 19-22 日、 東北学院大学(宮城県・仙台)

A. Noguchi et al., Electromechanical SiN-membrane inside a 3D microwave cavity, Gordon Research Conference: Mechanical System in the Quantum Regime, March 6, 2016, Ventura (USA) A. Noguchi, Electromechanical system using a Si3N4 membrane inside a 3D microwave cavity, International Symposium on Dynamics in Artificial Quantum Systems (DAQS2016), January 12-14, 2016, Tokyo(Japan)

R. Yamazaki, Opto-electromechanics for quantum transducer, International Symposium on Dynamics in Artificial Quantum Systems (DAQS2016), January 12-14, 2016, Tokyo(Japan)

A. Noguchi et al., Electromechanical SiN-membrane inside a 3D microwave cavity, International Symposium on Nanoscale Transport and Technology (ISNTT2015), November 17-20, 2015, Atsugi(Japan)

Yamazaki et al.. Opto-Electromechanical System as a Quantum Transducer, 28th International Symposium Superconductivity (ISS2015), November 16-18, 2015, Tokyo(Japan) 野口 篤史 他、薄膜振動子と超伝導量 子回路の結合系の構築、日本物理学会第 70 回年次大会、2015 年 3 月 21-24 日、 早稲田大学(東京都・新宿区) 山崎 歴舟 他、薄膜振動子と超伝導量 子回路の結合系の構築、日本物理学会第 70 回年次大会、2015 年 3 月 21-24 日、 早稲田大学(東京都・新宿区)

[図書](計 0件)

[産業財産権]

出願状況(計 0件) 取得状況(計 0件)

〔その他〕

ホームページ等

http://www.qc.rcast.u-tokyo.ac.jp/

- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

山崎 歴舟 (YAMAZAKI, Rekishu) 東京大学・先端科学技術研究センター・助

研究者番号:00551409